

口頭セッション日程表(会場別1)

会場名	収容人数	2021年9月10日(金)		2021年9月11日(土)		2021年9月12日(日)		2021年9月13日(月)	
		午前		午後		午前		午後	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
N101	605	09:30 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 18:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 17:55 SP1【一般公開】赤崎勇先生追悼シンポジウム	09:00 ~ 11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 18:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶
N102	150	09:20 ~ 12:00 T21 晶癖の工学：宇宙がおりなす結晶成長	13:30 ~ 16:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:30 ~ 11:45 3.13 半導体光デバイス	13:30 ~ 15:55 T1 コロナ禍での物理（科学）教育とその他人材教育 - 東海地区などを取り組みに学ぶ-	09:00 ~ 11:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 17:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理		
N103	150		13:45 ~ 18:00 3.13 半導体光デバイス	09:00 ~ 11:45 3.10 光量子物理・技術		09:00 ~ 12:00 3.10 光量子物理・技術	13:30 ~ 17:45 3.10 光量子物理・技術	09:00 ~ 11:30 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	13:30 ~ 16:45 3.14 光制御デバイス・光ファイバー
N104	142	09:00 ~ 11:30 16.3 シリコン系太陽電池	13:00 ~ 18:15 16.3 シリコン系太陽電池	09:30 ~ 11:30 9.5 新規材料・新物性	13:30 ~ 17:00 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	09:00 ~ 11:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 15:15 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス		
N105	180		13:30 ~ 17:15 T7 最先端バイオメテックスが生み出す超高機能プロテア〜知覚・情報処理〜行動から発電まで〜	09:30 ~ 12:00 T9 固相における秩序とは何か：機能を生み出す秩序の概念展開	13:30 ~ 17:15 T9 固相における秩序とは何か：機能を生み出す秩序の概念展開		13:30 ~ 18:00 T22 脱炭素社会に向けたカーボンナノチューブの開発と応用〜発見30周年記念シンポジウム〜	09:00 ~ 12:00 3.9 テラヘルツ全般	13:30 ~ 17:15 3.9 テラヘルツ全般
N106	154	09:00 ~ 11:45 3.8 光計測技術・機器	13:30 ~ 16:30 3.8 光計測技術・機器	09:00 ~ 11:45 3.8 光計測技術・機器		09:30 ~ 12:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 16:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	10:30 ~ 11:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 15:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」
N107	154	09:00 ~ 12:15 3.6 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 16:45 3.6 超高速・高強度レーザー	09:00 ~ 12:00 23.1 合同セッションN「インフォマテックス応用」	13:30 ~ 18:00 23.1 合同セッションN「インフォマテックス応用」	10:00 ~ 11:15 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:00 3.1 光学基礎・光学新領域	09:00 ~ 12:15 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:30 8.4 プラズマライサイエンス
N201	250		13:30 ~ 16:55 T4 散乱・揺らぎ計算イメージングの最前線	09:00 ~ 12:10 T17 生命機能メカニズム解明のための光・磁気操作技術	13:30 ~ 17:15 T15 計測×デジタル・IoTがひらく次世代ヘルスケア	10:00 ~ 11:45 T23 データの蓄積と共有がもたらす革新と課題 ～マテリアルズインフォマテックスを中心に～	13:30 ~ 16:50 T23 データの蓄積と共有がもたらす革新と課題 ～マテリアルズインフォマテックスを中心に～	09:00 ~ 11:45 T2【一般公開】空気中の二酸化炭素濃度削減を目指した電解技術の動向	13:30 ~ 17:15 T2【一般公開】空気中の二酸化炭素濃度削減を目指した電解技術の動向
N202	150	09:30 ~ 12:00 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	13:30 ~ 18:30 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	10:45 ~ 12:00 CS.2 3.3 情報フォトンクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション		09:00 ~ 11:15 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	13:00 ~ 16:30 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	09:00 ~ 12:15 3.4 生体・医用光学	14:00 ~ 15:45 3.4 生体・医用光学
N203	150	09:00 ~ 11:45 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 16:00 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	09:00 ~ 12:30 T10 青電体デバイスの開発に向けた異面イオンダイナミクス		09:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 16:45 6.4 薄膜新材料	09:30 ~ 11:15 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 16:00 6.4 薄膜新材料
N204	142	09:00 ~ 12:15 CS.10 6.5 表面物理・真空と7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	13:30 ~ 18:30 6.5 表面物理・真空	09:30 ~ 12:15 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 17:00 13.9 化合物太陽電池		13:30 ~ 15:15 8.4 プラズマライサイエンス 15:30 ~ 17:30 8.6 Plasma Electronics English Session		
N205	180		13:00 ~ 15:15 3.2 材料・機器光学		13:30 ~ 16:45 CS.5 3.11 フォトニック構造・現象、3.12 ナノ領域光学・近接場光学のコードシェアセッション	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:45 ~ 17:45 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:45 ~ 17:15 12.4 有機EL・トランジスタ
N206	154	09:00 ~ 11:45 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:30 ~ 17:00 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術			09:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 18:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 11:30 2.4 医用応用	13:30 ~ 15:00 2.4 医用応用
N207	154	09:00 ~ 12:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 18:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:30 ~ 12:00 3.15 シリコンフォトンクス・集積フォトンクス	13:30 ~ 17:15 3.15 シリコンフォトンクス・集積フォトンクス	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 18:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 15:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス
N221	108	10:00 ~ 12:00 15.1 パルシド結晶成長	13:30 ~ 16:15 15.1 パルシド結晶成長			10:45 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:30 ~ 16:30 2.1 検出器デバイス開発		
N301	250	10:30 ~ 11:45 T19 福島第1原発廃炉と福島復興 ー応用物理学学会の会員として、私たちに何が出来るかー	13:15 ~ 16:15 T19 福島第1原発廃炉と福島復興 ー応用物理学学会の会員として、私たちに何が出来るかー	09:00 ~ 12:00 6.6 プローブ顕微鏡	13:30 ~ 17:15 T12 多層化する圧電材料研究へセンサー、アクチュエーターから5G、IoTまで	09:00 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 17:30 6.1 強誘電体薄膜	10:00 ~ 11:30 6.6 プローブ顕微鏡	13:00 ~ 17:45 6.6 プローブ顕微鏡
N302	150	10:30 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 17:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 17:00 17.3 層状物質	09:00 ~ 11:45 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 18:15 12.2 評価・基礎物性	09:30 ~ 12:15 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 17:00 12.1 作製・構造制御
N303	150	09:00 ~ 11:45 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 18:30 13.8 光物性・発光デバイス				13:30 ~ 16:30 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		
N304	142	13:30 ~ 16:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション		09:00 ~ 12:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 17:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 17:15 13.5 デバイス/配線/集積化技術	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	
N305	180	09:00 ~ 12:15 CS.8 4.5 Nanocarbon and 2D Materials. 17 ナノカーボンのコードシェアセッション	13:30 ~ 18:30 3.7 レーザープロセス	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 16:15 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 11:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 17:15 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 11:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	
N306	154	09:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 18:15 17.2 グラフェン	09:00 ~ 12:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	15:45 ~ 17:45 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	09:00 ~ 11:30 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:30 ~ 15:45 3.14 光制御デバイス・光ファイバー		
N307	154		13:30 ~ 17:15 7.1 X線技術	09:00 ~ 12:15 4.7 Quantum Optics and Nonlinear Optics	13:30 ~ 14:45 4.7 Quantum Optics and Nonlinear Optics	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 16:30 12.1 作製・構造制御	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	
N321	192	09:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセス	13:00 ~ 13:45 15.2 II-V族結晶および多元素結晶	09:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセス	13:30 ~ 15:45 3.7 レーザープロセス	09:15 ~ 12:00 3.11 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 17:45 3.11 フォトニック構造・現象	09:15 ~ 12:00 3.11 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 17:45 3.11 フォトニック構造・現象
N322	192		13:30 ~ 18:00 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	09:00 ~ 11:30 12.5 有機太陽電池	13:00 ~ 17:15 12.5 有機太陽電池	09:00 ~ 11:30 12.5 有機太陽電池	13:00 ~ 18:30 12.5 有機太陽電池	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:00 12.7 医用工学・バイオチップ
N323	192		13:00 ~ 16:15 13.3 絶縁膜技術	09:00 ~ 11:30 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 17:30 12.2 評価・基礎物性	09:45 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:00 ~ 16:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 12:00 8.3 プラズマナノテクノロジー	13:00 ~ 16:45 CS.11 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V族エピタキシャル結晶、エビタキシーの基礎のコードシェアセッション
N324	192		13:00 ~ 16:35 T16 カーボニエトリアルに向けて有機分子・バイオエレクトロニクスができること	09:00 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:30 ~ 16:45 T3 放射線計測技術および材料の現状と最新動向	09:00 ~ 11:30 10.5 磁場応用	13:30 ~ 17:30 T14 持続型社会に向けた弱磁場応用	09:00 ~ 11:30 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	13:00 ~ 16:30 3.12 ナノ領域光学・近接場光学
N401	108	09:00 ~ 11:30 7.2 電子ビーム応用	13:00 ~ 15:45 7.2 電子ビーム応用	09:00 ~ 10:15 7.3 微細パターン・微細構造形成技術 10:45 ~ 11:30 7.4 量子ビーム界面構造計測	13:00 ~ 14:45 11.1 基礎物性	10:00 ~ 11:45 11.1 基礎物性	13:15 ~ 15:30 11.1 基礎物性		
N402	108	09:00 ~ 11:30 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.5 イオンビーム一般のコードシェアセッション	13:00 ~ 15:45 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.5 イオンビーム一般のコードシェアセッション	09:15 ~ 11:30	13:00 ~ 15:45 11.3 超伝導電流、超伝導パワーストック	09:00 ~ 12:00 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	13:30 ~ 16:15 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長		
N403	108	09:00 ~ 12:30 9.1 誘電材料・誘電体	13:30 ~ 18:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:00 ~ 14:15 11.4 アナログ応用および関連技術	13:00 ~ 14:15 11.4 アナログ応用および関連技術	09:00 ~ 11:00 11.4 アナログ応用および関連技術	13:00 ~ 16:45 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	09:00 ~ 11:15 9.3 ナノエレクトロニクス	13:00 ~ 15:15 9.3 ナノエレクトロニクス
N404	108	09:00 ~ 11:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:00 ~ 17:45 4.1 Plasmonics and Nanophotonics		13:00 ~ 16:00 4.6 Terahertz Photonics	09:00 ~ 12:00 CS.2 3.3 情報フォトンクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	13:30 ~ 18:00 CS.2 3.3 情報フォトンクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	09:00 ~ 11:30 CS.4 3.6 超高速・高強度レーザー、3.7 レーザープロセス、4.3 Lasers and laser materials processingのコードシェアセッション	13:30 ~ 16:00 CS.4 3.6 超高速・高強度レーザー、3.7 レーザープロセス、4.3 Lasers and laser materials processingのコードシェアセッション

口頭セッション日程表(会場別2)

会場名	収容人数	2021年9月10日(金)		2021年9月11日(土)		2021年9月12日(日)		2021年9月13日(月)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
N405	108	09:00 ~ 12:15 CS.6 3.13 半導体光デバイス、4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonicsのコードシェアセッション	13:45 ~ 17:15 CS.7 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス、4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonicsのコードシェアセッション		13:00 ~ 15:30 CS.8 4.5 Nanocarbon and 2D Materials. 17 ナノカーボンのコードシェアセッション	09:00 ~ 11:30 4.6 Terahertz Photonics	13:00 ~ 16:00 4.6 Terahertz Photonics	09:00 ~ 10:15 16.2 エナジーハーベスティング	
N406	108	09:15 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:30 ~ 18:30 9.4 熱電変換			09:00 ~ 12:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:00 ~ 16:15 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	09:30 ~ 11:30 9.5 新機能材料・新物性	13:00 ~ 17:00 9.5 新機能材料・新物性
S101	510	09:00 ~ 12:50 T25 AI7クセラータ：人工知能デバイスの新展開	13:30 ~ 17:15 T6 グローバル量子暗号通信の展開	09:50 ~ 12:10 NT1【一般公開】就活生必見！半導体の進化無くしてAIの進化無し	13:30 ~ 18:00 T24【一般公開】量子コンピュータ：システム構築のための技術と期待されるアプリケーション	09:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセッション「AI/エレクトロニクス」	13:00 ~ 17:30 FS.1 フォーカストセッション「AI/エレクトロニクス」	09:00 ~ 11:45 FS.1 フォーカストセッション「AI/エレクトロニクス」	
S201	398		13:00 ~ 17:05 T5 フォトニクスが生み出すイノベーションと新産業創出IV ～羽ばたく産学発フォトニクスベンチャー～	09:00 ~ 12:00 T8 薄膜・表面物理研究のトレンドと今後の展望 ～薄膜・表面物理分科会50周年記念シンポジウム～	13:00 ~ 18:30 T8 薄膜・表面物理研究のトレンドと今後の展望 ～薄膜・表面物理分科会50周年記念シンポジウム～	09:00 ~ 11:45 T18 次世代発光材料の創製とデバイス応用	13:00 ~ 15:45 T18 次世代発光材料の創製とデバイス応用	09:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 16:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」
S202	228		13:00 ~ 17:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	10:00 ~ 11:30 3.5 レーザー装置・材料	13:00 ~ 15:30 3.5 レーザー装置・材料 15:45 ~ 16:45 CS.3 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション		13:00 ~ 18:30 2.5 放射線誘起蛍光体	09:30 ~ 12:00 2.5 放射線誘起蛍光体	13:30 ~ 17:40 T20 センサ融合に向けたセンサ集積技術
S203	228	09:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 18:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00 ~ 11:30 3.9 デラヘルツ全般		09:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 16:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス
S301	304	09:00 ~ 11:30 8.1 プラズマ生成・診断	13:00 ~ 14:00 8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 14:00 ~ 16:30 8.1 プラズマ生成・診断	09:00 ~ 11:40 T11 未来デバイス製造のためのアトミックレイプロセス；表面反応ダイナミクスの理解と制御	13:30 ~ 16:55 T11 未来デバイス製造のためのアトミックレイプロセス；表面反応ダイナミクスの理解と制御	09:00 ~ 12:00 6.2 カーボン系薄膜	14:00 ~ 18:00 6.2 カーボン系薄膜	09:30 ~ 11:15 6.2 カーボン系薄膜	13:00 ~ 17:15 6.2 カーボン系薄膜
S302	273	09:00 ~ 12:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:30 ~ 18:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	09:00 ~ 12:00 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・トランジスタ技術	13:30 ~ 18:00 T13 理論と実験の協奏：スピントロニクス材料・現象・素子	09:00 ~ 10:45 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・トランジスタ技術 11:00 ~ 12:00 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	13:30 ~ 18:15 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	09:00 ~ 12:00 10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）	13:30 ~ 17:45 10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）
S401	108	09:00 ~ 12:00 1.1 応用物理一般・学際領域	13:30 ~ 17:45 1.1 応用物理一般・学際領域	09:00 ~ 11:00 1.2 教育	13:00 ~ 17:45 1.6 超音波	09:15 ~ 11:30 1.3 新技術・複合新領域	13:00 ~ 18:15 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境		13:00 ~ 15:45 1.5 計測技術・計測標準
S402	108	09:00 ~ 12:30 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:30 12.7 医用工学・バイオチップ			09:00 ~ 11:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00 ~ 17:00 12.6 ナノバイオテクノロジー		

ポスターセッション日程表(分科別)

分科名	開催日時
1 応用物理学一般	
1.1 応用物理一般・学際領域 1.2 教育 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 1.5 計測技術・計測標準 1.6 超音波	9月21日(火) 9:00~10:40
2 放射線	9月21日(火) 11:00~12:40 13:00~14:40
3 光・フォトンクス	
3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 材料・機器光学 3.4 生体・医用光学 3.5 レーザー装置・材料 3.7 レーザープロセス	9月21日(火) 15:00~16:40
3.8 光計測技術・機器	9月23日(木) 9:00~10:40
3.9 テラヘルツ全般 3.10 光量子物理・技術 3.11 フォトニック構造・現象 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	9月21日(火) 17:00~18:40
6 薄膜・表面	
6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料	9月22日(水) 9:00~10:40
6.5 表面物理・真空 6.6 プローブ顕微鏡	9月22日(水) 11:00~12:40
7 ビーム応用	9月22日(水) 11:00~12:40
8 プラズマエレクトロニクス	9月22日(水) 11:00~12:40 13:00~14:40
9 応用物性	
9.1 誘電材料・誘電体 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 9.4 熱電変換 9.5 新機能材料・新物性	9月23日(木) 13:00~14:40
10 スピントロニクス・マグネティクス	9月22日(水) 11:00~12:40 13:00~14:40
11 超伝導	9月22日(水) 13:00~14:40

分科名	開催日時
12 有機分子・バイオエレクトロニクス	
12.1 作製・構造制御 12.2 評価・基礎物性	9月22日(水) 15:00~16:40
12.3 機能材料・萌芽のデバイス	9月23日(木) 9:00~10:40
12.4 有機EL・トランジスタ	9月22日(水) 15:00~16:40
12.5 有機太陽電池 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ	9月22日(水) 17:00~18:40
13 半導体	
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁膜技術 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	9月23日(木) 9:00~10:40
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 13.8 光物性・発光デバイス 13.9 化合物太陽電池	9月23日(木) 11:00~12:40
15 結晶工学	
15.1 バルク結晶成長 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.4 III-V族窒化物結晶 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶 15.6 IV族系化合物 (SiC) 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	9月23日(木) 13:00~14:40
16 非晶質・微結晶	
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス 16.3 シリコン系太陽電池	9月23日(木) 9:00~10:40
17 ナノカーボン	9月23日(木) 15:00~16:40 17:00~18:40
合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	9月23日(木) 15:00~16:40
合同セッションN「インフォマティクス応用」	9月23日(木) 17:00~18:40

※上記に記載のない中分類はポスターセッションは開催しません。